

Total No. of Printed Pages—7

6 SEM TDC PHY G 1

2 0 1 8

(May)

PHYSICS

(General)

Course : 601

(Electronics and Solid-state Physics)

Full Marks : 56

Pass Marks : 22/17

Time : 2½ hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions*

1. তলত দিয়াসমূহৰ নির্দেশানুসৰি উত্তৰ দিয়া : $1 \times 6 = 6$

Answer the following as directed :

(a) ফেচেন্টের'ড কিউবিক লেটিচৰ পাবমাণবিক ব্যাসাধ (r)
হ'ল

The atomic radius (r) of face-centred cubic lattice is

(i) $\frac{a}{2}$

(ii) $\frac{a}{2\sqrt{2}}$

(iii) $\frac{\sqrt{3}}{4}a$

য'ত a হ'ল লেটিচ প্রৱৰ্ক !

where a is lattice constant.

(শুন্দি উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

(Choose the correct answer)

(Turn Over)

(2)

- (b) ট্রেজিস্টর α আৰু β ৰ মাজৰ সম্পর্কটো হ'ল

The relation between α and β of a transistor is

$$(i) \alpha = \frac{\beta}{\beta - 1}$$

$$(ii) \alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

$$(iii) \alpha = \frac{\beta - 1}{\beta}$$

(শুন্দি উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

(Choose the correct answer)

- (c) সৰল ঘনকীয় সজ্জাৰ পেকিং ভগ্নাংশৰ মান হ'ল
Packing fraction for simple cubic lattice is

(i) 52%

(ii) 68%

(iii) 74%

(শুন্দি উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

(Choose the correct answer)

(3)

- (d) বিভৱ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে তলৰ কোনবিধি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ?

Which of the following devices is used for the purpose of voltage regulation?

(i) P-N জাংছন

P-N junction

(ii) জেনাৰ ডায়’ড

Zener diode

(iii) ট্ৰেজিস্টৰ

Transistor

(iv) ধাৰক

Capacitor

(শুন্দি উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

(Choose the correct answer)

- (e) মিলাৰ সূচকাংক কি ?

What is Miller indices?

(Turn Over)

- (f) CE সঞ্জাবিশিষ্ট ট্রেন্সিস্টর পরিবর্ধক এটাৰ বিষয়ে তলৰ
কোনটো উক্তি শুন্দ ?

Which of the following statements about
a transistor amplifier in CE configuration
is correct?

(i) নিরেশকৰ বোধৰ মান অত্যন্ত বেছি

Input impedance is very high

(ii) নিরেশকৰ বোধৰ মান নিচেই কম

Input impedance is very low

(iii) বিবৰ্ধনৰ মান সদায়েই একতকে কম

Amplification is always less than
one

(iv) ই নিরেশক আৰু আবেশক সংকেতৰ মাজত
180° দশা পার্থক্যৰ সৃষ্টি কৰে

It produces 180° phase shift
between the input and output signal

(শুন্দ উভয়টো বাছি উলিওৱা)

(Choose the correct answer)

2. তলত দিয়া যি কোনো ছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা : $2 \times 6 = 12$

Answer any six questions from the following :

(a) বিভৱ নিয়ন্ত্ৰক এটাৰ বৰ্তনী অংকন কৰা।

Draw the circuit of a voltage regulator.

(b) ট্রেন্সিস্টৰ বায়েছিঙ্গ (biasing) প্ৰয়োজনীয়তা কি কি ?

What are the needs of transistor
biasing?

- (c) P-N জাংছন এটাৰ ক্ষেত্ৰত নিঃশেষ অঞ্চল গঠনৰ বিষয়ে
আলোচনা কৰা।

Discuss the formation of depletion layer
in a P-N junction.

- (d) এফ.চি.চি. (f.c.c.) সঞ্জাৰ পেকিং তথ্য নিৰ্ণয় কৰা।

Find the packing fraction for f.c.c.
lattice.

- (e) প্ৰিমিটিভ লেটিচ কোষ কি? এটা ত্ৰিমাত্ৰিয় প্ৰিমিটিভ
লেটিচ কোষ এটা উদাহৰণ দি বুজাই লিখা।

What is a primitive lattice cell? Explain
a three-dimensional primitive lattice cell
giving an example.

- (f) এটা CE সঞ্জাত থকা ট্রেন্সিস্টৰ বাবে তৃমি প্ৰবাহৰ মান
0.5 mA হ'লে সংগ্ৰহক প্ৰবাহৰ মান কিমান হ'ব?
(দিয়া আছে $\alpha = 0.96$)

If a transistor is in CE configuration and
its base current is 0.5 mA, then what
will be the value of collector current?
(Given that $\alpha = 0.96$)

- (g) উইডেমেন-ফ্ৰেঞ্চ সূত্ৰটো লিখা।

Write the Wiedemann-Franz law.

3. (a) CE ট্রেন্সিস্টৰ পৰিবৰ্ধক এটাৰ কাৰ্যপ্ৰণালী আলোচনা
কৰা। লগতে পৰিবৰ্ধকটোৰ পৰিবৰ্ধন গণনা কৰা। $3+1=4$
Discuss the working of a CE transistor
amplifier. Also calculate its gain.

(6)

- (b) P-N জাংছনৰ বৈশিষ্ট্য বক্র অংকনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সঁজুলিৰ চিত্ৰ অংকন কৰা। লগতে পৰিস্কাৰ চিত্ৰসহ বৈশিষ্ট্য বক্র সম্পর্কে আলোচনা কৰা।

Design an experimental setup to draw the characteristic curves of a P-N junction. Also discuss about the characteristic curves with neat diagram.

- (c) উপযুক্ত চিত্ৰৰ সহায়ে বাইন ব্ৰীজ দোলক এটাৰ কাৰ্যপ্ৰণালী ব্যাখ্যা কৰা।

Explain the working of a Wien bridge oscillator with necessary diagram.

- (d) ব্ৰেগৰ সমীকৰণটো নিৰ্ণয় কৰা। ঘনকীয় স্ফটিকত 1.54 Å তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ এক্সে ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথম স্তৰ (100)ৰ পৰা হোৱা প্ৰতিফলন কোণৰ মান 18° হ'লে স্ফটিকটোৰ (100) আৰু (111) তলকেইখনৰ মাজৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা।

$$3+3=6$$

Deduce Bragg's equation. Using X-ray of wavelength 1.54 Å in cubic crystal if the reflection angle on the first layer (100) is 18° , then find the distance between (100) and (111) planes of the crystal.

4. (a) স্ফটিকৰ শক্তি-পটি তত্ত্বৰ আধাৰত পৰিবাহী, অধিপৰিবাহী আৰু অন্তৰকৰ মাজৰ বৈদ্যুতিক আচৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা।

Discuss the electrical behaviour of conductors, semiconductors and insulators with the help of energy band theory of crystals.

8P/726

(7)

- (b) চ'ডিয়াম ক্ল'বাইড আৰু জিংক ছালফাইডৰ স্ফটিক গঠন বৰ্ণনা কৰা।

Describe the NaCl and ZnS crystal structure.

- (c) অতিপৰিবাহিতাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন উৎকৃষ্টা, সংকট ক্ষেত্ৰ আৰু মেচনাৰ প্ৰভাৱ মানে কি বুজা ?

What do you understand by transition temperature, critical field and Meissner effect in case of superconductivity?

- (d) টাইপ-I আৰু টাইপ-II অতিপৰিবাহী বুলিলে কি বুজা ?
What do you mean by type-I and type-II superconductors?

★ ★ ★

(Continued)

8P-3000/726

6 SEM TDC PHY G 1